



## P型铜铁矿基氧化物臭氧气敏半导体材料及其制备方法

文献类型: 专利

.....

**作者** 邓赞红<sup>1</sup>; 邓赞红<sup>1</sup>; 方晓东<sup>1</sup>; 陶汝华<sup>1</sup>

**发表日期** 2008

**专利国别** 中国

**专利号** 101308109

**专利类型** 发明

**权利人** 中国科学院安徽光学精密机械研究所

**公开日期** 2013-01-17

**申请日期** 2007

**专利申请号** 200710191278.1

**源URL** [http://ir.hfcas.ac.cn/handle/334002/9983]

**专题** 合肥物质科学研究院\_中科院安徽光学精密机械研究所

**推荐引用方式** 邓赞红,邓赞红,方晓东,等. P型铜铁矿基氧化物臭氧气敏半导体材料及其制备方法, P型铜铁矿基氧化物臭氧气敏半导体材料及其制备方法, P型铜铁矿基氧化物臭氧气敏半导体材料及其制备方法, P型铜铁矿基氧化物臭氧气敏半导体材料及其制备方法, P型铜铁矿基氧化物臭氧气敏半导体材料及其制备方法, P型铜铁矿基氧化物臭氧气敏半导体材料及其制备方法, P型铜铁矿基氧化物臭氧气敏半导体材料及其制备方法, P型铜铁矿基氧化物臭氧气敏半导体材料及其制备方法. 101308109. 2008-01-01.

入库方式: OAI收割

来源: [合肥物质科学研究院](#)

浏览	下载	收藏
193	61	0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。

